

# 国立研究開発法人産業技術総合研究所共用施設等利用約款

制定 平成25年12月1日  
最終改正 令和2年3月26日 一部改正

## (適用範囲)

第1条 この約款は、国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「研究所」という。）が保有する研究施設、研究設備及び研究装置であって、別表第1に掲げるもの（以下「共用施設等」という。）を国立研究開発法人産業技術総合研究所共用施設等の利用に関する規程（25規程第60号）及び共用施設等の登録、公開及び利用に係る業務実施要領（27要領第123号）に基づき、利用する場合に適用します。

## (定義)

- 第2条 この約款において「利用」とは、利用者が、研究所内において共用施設等を用いてデータ等の取得及び試料等の処理等を行うこと（第5条第1項の役務提供、同条第2項の技術指導及び同条第3項の技術代行を受ける場合を含む。）をいいます。
- 2 この約款において「利用者」とは、第3条第2項の規定に基づき研究所との間で共用施設等の利用契約を締結した者をいいます。
- 3 この約款において「利用希望者」とは、共用施設等の利用を希望する者であって、研究所との間で利用契約を締結していない者をいいます。
- 4 この約款において「役職員等」とは、研究所の役員、職員及び契約職員並びに研究所の業務を行う者であって役員、職員及び契約職員以外の者をいいます。
- 5 この約款において「知的財産権」とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所職務発明取扱規程（13規程第26号。以下「職務発明取扱規程」という。）第2条に規定する権利、著作権法（昭和45年法律第48号）に規定する著作権及び外国における前記の権利に相当する権利並びにその他の知的財産（知的財産基本法（平成14年法律第122号）第2条第1項の知的財産をいう。）に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます。
- 6 この約款において「秘密情報」とは、研究所又は利用者が相手方に開示した技術情報及び自己の事業に係る技術情報以外の情報であって、秘密である旨の表示がなされている書類又は電磁的記録（複製されたものを含む。）及び口頭で開示された情報のうち、開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で開示者から開示内容を特定のうへ秘密である旨通知されたものをいいます。ただし、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
- 一 相手方からの知得時に既に公知の情報又は相手方から知得後に自己の責めに帰すべき事由によることなく公知となった情報
  - 二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
  - 三 相手方から情報を知得した時点で既に自己が保有していたことを書面により立証できる情報
  - 四 相手方から知得した情報によらないで独自に創出したことが書面により立証できる情報
  - 五 相手方から開示を受けた後、相手方が秘密である旨示した情報によらず、独自に創出した情報
  - 六 相手方から書面により開示の承諾を得た情報
  - 七 法令又は裁判所の命令により開示を義務付けられた情報
- 7 この約款において「発明等」とは、職務発明取扱規程第2条第7項に規定するものをいいます。

## (利用の方法)

- 第3条 共用施設等の利用希望者は、あらかじめ研究所における当該共用施設等の施設管理者（以下「施設管理者」という。）の内諾を得た上で、「共用施設等利用申込書」（別紙様式第1。以下「申込書」という。）を提出してください。
- 2 研究所は、次に掲げる要件が全て満たされていると認める場合には、共用施設等利用回答書（別紙様式第2。以下「回答書」という。）により利用を受け入れることを通知します。この通知により、研究所と利用希望者との間に本約款に基づく共用施設等の利用契約（以下「本利用契約」という。）が成立するものとします。
- 一 利用希望者が、反社会的勢力等と関係を有していないこと。
  - 二 利用希望者及び利用目的に関して、安全保障輸出管理上及び情報管理上の懸念がないこと。
  - 三 利用が、研究所の研究業務に支障を来すおそれがないこと。
  - 四 利用が、我が国の産業競争力を損なうおそれがないこと。
  - 五 前各号に掲げるもののほか、共用施設等の利用が不相当と認められる特段の事由がないこと。
- 3 研究所は、前項各号に掲げる要件が満たされていることを認めるに当たり、第三者の意見を聞くことができます。

4 研究所は、第2項各号に掲げる要件のいずれかが満たされない場合には、回答書により受入れができないことを通知します。

(利用の受入れの取消し又は中止及び事実の公表)

第4条 研究所は、前条第2項各号に掲げる要件のいずれかが満たされない事態が生じ、又は利用者が第8条第1号から第6号まで及び第8号のいずれかに違反した場合には、利用者に対し、前条第2項に規定する利用の受入れを取り消し、又は利用の中止を命ずることができます。

2 研究所は、前項の規定にかかわらず、研究所が管理上の必要があると認める場合には、利用者に対し、前条第2項に規定する利用の受入れを取り消し、又は利用の中止を命ずることができます。

3 研究所は、第1項の規定により利用の受入れを取り消し、又は利用の中止を命じた場合には、これらの事実を公表することができます。

4 本利用契約は、第1項及び第2項の規定による利用の受入れの取消し又は利用中止命令により、解除されたものとします。

(役務提供、技術指導及び技術代行)

第5条 研究所は、利用者が希望する場合には、利用者と施設管理者との協議の上、共用施設等の操作、運転等の役務提供を利用者に実施することができます。

2 研究所は、利用者が希望する場合には、利用者と施設管理者との協議の上、共用施設等の操作及び運転方法、実験試料等の作製方法、実験データ等の解析方法等に関する技術指導を利用者に実施することができます。

3 研究所は、利用者が希望する場合には、利用者と施設管理者との協議の上、観察、分析、解析、加工、試料作製等に関する技術代行を利用者に実施することができます。

4 利用者は、利用に際し研究所に登録された知的財産権の開示又は実施許諾を受ける必要がある場合には、研究所と別途、当該開示又は実施許諾に係る契約を締結するものとします。

(利用料等)

第6条 利用者は、次の各号の合計額に消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）を加えた額（以下「利用料等」という。）を所定の期日までに納付するものとします。ただし、文部科学省からの委託事業「ナノテクノロジープラットフォーム」対象事業（以下「文部科学省委託事業」という。）のため共用施設等を利用する場合の利用料等に関しては、第6号の運営管理費は含まないものとします。

一 共用施設等使用料

二 運転費（前条第1項に係る費用）

三 技術指導費（前条第2項に係る費用）

四 技術代行費（前条第3項に係る費用）

五 追加料金

六 運営管理費

2 研究所は、利用者が文部科学省委託事業のために共用施設等を利用する場合の利用料等の単価は、通常の単価より低いものを設定します。

3 利用者は、第16条第1項ただし書により成果の公開をしないこととした場合には、研究所が指定する日までに通常の単価により算定される額から前項の規定による低い単価により算定される額を控除した額及び通常の単価により算定される第1項第6号の運営管理費を納付するものとします。

4 第1項及び第2項の利用料等の算定方式については、共用施設等ごとに別紙第1に定めるものとします。

5 研究所は、利用者の従業員であって共用施設等の利用に携わる者を研究所に受け入れた場合において、前4項に加え、連携研究等経費算定要領（19要領第15号）別表第3に定める人頭経費を徴収する場合があります。

(利用料等の返還)

第7条 研究所は、原則として利用者が納付した利用料等を返還しません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用した期間に応じて、当該利用料等の全部又は一部を返還します。

一 利用者の責によらない共用施設等の故障又は天災等のやむを得ない事情により、当該共用施設等の利用が不可能になった場合

二 第4条第2項の規定により、研究所が利用の受入れを取り消し、又は利用の中止を命じた場合

三 利用料等の納付方法が利用前払い及び精算方式の場合であって、利用した期間が回答書に記載した利用の期間より短い場合で、研究所が返還の必要性があると認めた場合

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守してください。

一 本約款及び回答書に記載されている事項

二 施設管理者の指示及び共用施設等ごとに定められている利用に際して守るべき事項

- 三 危険を惹起する行為又はそのおそれがある行為を行わないこと。
- 四 日本国の法令に違反する行為を行わないこと。
- 五 共用施設等を破損するおそれがある行為を行わないこと。
- 六 研究所の業務遂行に支障を来す行為又はそのおそれがある行為を行わないこと。
- 七 利用終了時には、共用施設等を利用開始前の状態に復帰させること。
- 八 その他、研究所の定める事項

(秘密情報の取扱い等)

第9条 研究所及び利用者は、相手方が開示した秘密情報について、厳に秘密を保持するものとし、書面による相手方の承諾なくして、第三者に漏洩しないものとします。

- 2 研究所及び利用者は、秘密情報の管理について、取扱責任者を定め厳重に管理します。
- 3 研究所及び利用者は、研究所の役職員等又は利用者の従業員であって共用施設等の利用に携わる者に対してのみ、秘密情報を開示するものとし、開示に際し、秘密情報が秘密を保持すべき事項であることを明示するとともに、当該研究所の役職員等又は利用者の従業員は、研究所及び利用者が本約款に基づき負うと同様の義務を負うものとします。
- 4 利用者は、研究所の開示した秘密情報による発明等又は研究所の開示した秘密情報を含む発明等を創製した場合には、直ちに研究所にその旨を通知するものとし、研究所及び利用者は当該発明等の取扱いについて協議することとします。
- 5 利用者が研究所に開示する秘密情報は、共用施設等の利用目的に照らし必要最小限の範囲に留めなければなりません。
- 6 利用者は、盗聴、盗撮、リバースエンジニアリングその他の正当ではない手段を用いて、研究所又は他の利用者等の第三者の技術情報にアクセスする行為を行ってはなりません。

(成果の帰属)

第10条 利用者の利用により得られた知的財産権は、原則として利用者に帰属するものとします。ただし、研究所から第5条第2項の技術指導若しくは同条第3項の技術代行を受けた場合又は当該知的財産権が共用施設等若しくは研究所が予め用意したその操作、運転等の方法に係るものである場合には、研究所及び利用者は協議することとします。

- 2 前項において、研究所と利用者との協議により、利用により得られた知的財産権の一部又は全部が研究所に帰属することとなった場合には、その取扱いについて別途契約により定めることとします。
- 3 第1項ただし書の規定にかかわらず、利用者が共用施設等を利用し、新たに有体物を作成した場合には、当該有体物に研究所の材料又は試料を用いる場合を除き、当該有体物は利用者に帰属するものとします。
- 4 利用者は、利用により第1項の協議の対象となる発明等を創製した場合には、研究所に報告するものとします。

(事故処理)

第11条 利用者は、共用施設等の利用中に事故、緊急事態等が発生した場合には、直ちに研究所に通報し、その指示に従わなければなりません。

(免責)

第12条 研究所は、共用施設等の利用により又は利用に伴い発生した事故及び事件等に起因して利用者又は第三者に生じた損害について、損害賠償責任を含む一切の法的責任を負いません。ただし、研究所が意図的に当該事故及び事件等を惹き起こした場合には、この限りではありません。

- 2 研究所は、共用施設等の故障、不具合等により生じた利用者及び第三者の損害について、損害賠償責任を含む一切の法的な責任を負いません。
- 3 研究所は、第4条第1項及び第2項に定める利用の受入れの取消し又は利用中止命令に起因して又は関連して生じた利用者及び第三者の損害について、損害賠償責任を含む一切の法的な責任を負いません。
- 4 研究所は、利用者が持ち込んだ試料等の滅失又は毀損に対しては、研究所の故意又は重大な過失による場合を除き、損害賠償責任を含む一切の法的な責任を負いません。
- 5 利用者の利用行為、利用により創出した成果又は当該成果を用いた利用者の製造販売等の行為が、第三者の権利を侵害するとして請求がなされた場合には、利用者は自らの費用と責任により当該紛争を解決するものとし、研究所は損害賠償責任を含む一切の法的な責任を負いません。
- 6 研究所が損害賠償責任を負う場合には、その範囲は直接及び通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、特別損害及び間接損害は含みません。

(弁償義務)

第13条 利用者の故意若しくは過失又は第8条の遵守事項に違反する行為によって、共用施設等の破損等の損害を研究所に与えた場合には、研究所は、その損害賠償を利用者及びその従業員に請求することができます。

2 利用者による共用施設等の利用行為に起因して又は関連して第三者が損害を受けたとして、第三者から研究所に請求がなされた場合には、利用者は当該請求により研究所に発生した費用及び損害を負担するものとします。

3 前項の規定は、前条第5項の利用者の利用行為、利用により創出した成果又は当該成果を用いた利用者の製造販売等の行為が、第三者の権利を侵害するとして第三者から研究所に請求がなされた場合に準用されるものとします。

(利用契約の有効期間)

第14条 本利用契約は、回答書に記載した利用の期間に限り有効とします。ただし、本約款中、第4条第3項の規定は利用の期間の終了後1年間有効とし、第9条の規定は利用の期間終了後5年間有効とし、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条、第20条及び第21条の規定は利用の期間終了後も有効とします。

(製造物責任等)

第15条 研究所及び利用者は、共用施設等を利用した製造については、専ら利用者が製造者としての責任を負うものであることを確認するものとします。

2 研究所及び利用者は、共用施設等の利用による製造物及びその製造方法について、研究所が製造物責任を含む一切の法的責任を負わないことを確認するものとします。

3 第13条第2項の規定は、共用施設等の利用による製造物について、第三者から研究所に製造物責任があるとして請求がなされた場合に準用します。

(国等からの委託事業に基づく成果の公開及び報告)

第16条 利用者が国等からの委託事業に基づく成果の公開を前提として共用施設等を利用する場合には、研究所及び利用者は、共用施設等の利用の終了後、成果を公開しなければなりません。ただし、成果中に公開することにより業務に支障を来す部分が含まれているとして、利用者から当該部分を公開しないよう申入れがあり、かつ、公開しないことにつき相当の理由があると認められる場合には、当該部分の全部又は一部を公開しないことができます。

2 利用者は、前項本文に規定する場合は、共用施設等を利用した後1か月以内に、利用報告書を提出しなければなりません。ただし、研究所が利用者からの申出により利用報告書を提出しないことについて相当の理由を認めたときは、提出を省略することができます。

3 利用者は、第1項本文に規定する場合において、その公開する成果に関し、ねつ造、改ざん及び盗用、並びに不適切なオーサiership、二重投稿等を行ってはなりません。

(無断利用)

第17条 利用者は、回答書に記載した利用の期間を超えて共用施設等を利用することはできません。

2 利用者が研究所の書面による同意を得ることなく、回答書に記載した利用の期間以外の期間に共用施設等を利用した場合には、利用者は、研究所に対して、使用損害金として、当該期間に係る利用料等(第6条第1項第2号から第5号までを除く。)の倍額に相当する金銭を支払わなければなりません。

(譲渡の禁止)

第18条 利用者は、研究所の事前の書面による同意なく、本利用契約上の地位又は本利用契約に基づく権利及び義務を譲渡し、移転し、又は担保に供してはなりません。

2 前項に反して、利用者が本利用契約上の地位又は本利用契約に基づく権利及び義務を譲渡し、移転し、又は担保に供したことにより研究所に費用負担又は損害が生じた場合には、利用者は、研究所に対して、合理的な弁護士費用を含む費用を支払い、損害を賠償する義務を負わなければなりません。

(約款の変更)

第19条 本約款を変更する場合には、本約款に特に定めない限り、既に締結された利用契約にも変更後の本約款が適用されるものとします。

2 本約款を変更する場合は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容、その効力発生時期等について、研究所のウェブページに掲載します。

(準拠法)

第20条 本利用契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

(合意管轄)

第21条 研究所及び利用者は、本利用契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

(その他)

第22条 本約款に関し疑義が生じた場合又は本約款に記載のない事項若しくはその取り決め等については、研究所と利用者で誠意をもってその都度協議するものとします。

附 則

この約款は、平成25年12月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成26年6月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成26年7月1日から適用する。

- 一 別表第1 表4
- 二 別表第1 表5
- 三 別表第2 2. 中の「、NPF並びにGreFONの施設」

附 則（一部改正）

- 1 この約款は、平成26年10月1日から施行する。
- 2 この約款の施行前に締結した契約については、当該契約を変更又は終了するまでの間は、なお従前の例による。

附 則（一部改正）

この約款は、平成27年4月1日から施行する。

附 則（一部改正）

- 1 この約款は、平成27年6月1日から施行する。
- 2 この約款の施行前に締結した契約については、当該契約を変更又は終了するまでの間は、なお従前の例による。

附 則（一部改正）

この約款は、平成27年11月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成28年4月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成28年12月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成29年4月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成29年7月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成30年4月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成30年10月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成30年11月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、平成31年4月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、令和元年10月1日から施行する。

附 則（一部改正）

この約款は、令和2年4月1日から施行する。



(別表第1)

## 共用施設等一覧

## 1. スーパークリーンルーム産学官連携研究棟 (以下「SCR」という。)

No.	装置番号	施設等名称	備考	
			メーカー名	型番
1	L01-104	ArF 液浸レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK LITHIUS i+
	L01-103	ArF 液浸露光装置	Nikon	NSR-S610C
2	M01-08	KrF レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
	M01-10	KrF 露光装置	Canon	FPA-5000ES3
3	U01-102	i 線レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
	U01-101	IR アラインメント付 i 線露光装置	Canon	FPA-5510iZs
4	AH08-107	EUV フレーム露光装置	リソテックジャパン	EUVES-7000GC
5	L01-104c	ArF 液浸レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK LITHIUS i+
6	M01-08c	KrF レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
7	U01-102c	i 線レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
8	M01-04	レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
9	I 03-101	マニュアル有機現像装置	リソテックジャパン	Litho Spin Cup 300D
10	B03-07	プラズマ CVD 装置	ASM	Eagle-12
11	M03-06	プラズマ CVD 装置	ASM	Eagle-12 Rapidfire
12	B03-06	プラズマ CVD 装置	Novellus systems	VECTOR
13	F03-103	プラズマ CVD 装置	Novellus systems	VECTOR
14	M03-01	高密度プラズマ CVD 装置	Novellus systems	Concept 3 Speed
15	P03-101	高密度プラズマ CVD 装置	三菱重工	MAPLE
16	M03-14	High-k ALD 装置	東京エレクトロン	Trias-ALD
17	M06-04	メタル CVD 装置	東京エレクトロン	Trias-W
18	F03-07	窒化膜 LP-CVD 装置	東京エレクトロン	TELFORMULA
19	M03-03	酸化膜 LP-CVD (TEOS) 装置	東京エレクトロン	TELFORMULA
20	P03-103	Doped-Si LP-CVD 装置	日立国際電気	DJ-1226V-DF
21	U03-101B	プラズマ CVD 装置	Applied Materials	PRODUCER GT Staircase
22	B06-101	バリアシードスパッタ装置	Applied Materials	Endura2 EnCoReII Ta/Cu
23	F06-101	新材料スパッタ装置	キャノンアネルバ	iarim C-7100GT
24	M06-03	メタルスパッタ装置	キャノンアネルバ	COSMOS I-1201
25	M06-07	メタルスパッタ装置	ULVAC	ENTRON W-300
26	B06-102	Cu メッキ装置	Novellus systems	SABRE NExT
27	P03-105	Ge エピ装置	キャノンアネルバ	FC7200
28	AP03-101	SiGe/Ge 成膜装置	ASM	Epsilon
29	M02-04	Poly-Si エッチング装置	Applied Materials	Centura DPSII/Axiom
30	M02-05	メタルエッチング装置	Applied Materials	Centura DPSII/ASPII
31	B02-101	Low-k/メタルエッチング装置	Applied Materials	Centura Enabler/DPS232
32	M02-01	酸化膜エッチング装置	東京エレクトロン	Telius SCCM-0x/DRM-0x
33	M02-10	酸化膜エッチング装置	東京エレクトロン	Telius DRM-0x/SCCM-Poly
34	B02-01	Low-k エッチング装置	東京エレクトロン	Telius SCCM-0x
35	F02-101	新材料エッチング装置	日立ハイテクノロジーズ	U-8150
36	B02-03	アッシング装置	芝浦メカトロニクス	ICE300/RPA300
37	M02-07	アッシング装置	芝浦メカトロニクス	μ ASH300
38	P02-105	アッシング装置	芝浦メカトロニクス	ICE300/μ ASH300
39	M05-03	高エネルギー中電流イオン注入装置	日新イオン機器	EXCEED2300V

No.	装置番号	施設等名称	備考	
			メーカー名	型番
40	F05-101	低エネルギー高電流イオン注入装置	住友重機械	SHX
41	M03-101	RTA/RTP 装置	Applied Materials	Radiance
42	M04-02	ゲート酸化 RTO/RTP 装置	東京エレクトロン	Trias SPA300
43	B04-01	縦型アニール装置	光洋サーモシステム	VF-5700B
44	M04-101	縦型酸化炉	東京エレクトロン	ALPHA-303i-K
45	M07-15	バッチ式洗浄装置	東京エレクトロン	UW300Z
46	M07-07	酸化膜ウェットエッチング装置	SES	VENUS
47	P07-104	窒化膜ウェットエッチング装置	S-TEC	SFAW-1201-008
48	M07-05	バッチ式スプレー洗浄装置	東京エレクトロン	ZETA 300 BE
49	U07-103c	Si 裏面研削研磨装置洗浄ユニット	ディスコ	DGP8761SC
50	M07-02	枚葉式洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN MP-3000
51	M07-101	枚葉式洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SU-3000
52	M07-102	枚葉式洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SU-3000
53	P07-105	枚葉式洗浄装置	カナメックス	KC-A300CBT
54	M07-13	枚葉式新材料洗浄装置	SEZ	SEZ323
55	P07-103	小口径対応枚葉式洗浄装置	ジャパנקリエイト	SRWC-12801-8P-2C
56	M07-09	スクラブ洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SS-3000
57	M07-12	スクラブ洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SS-3000
58	N07-101	STI、W CMP 装置	東京精密	ChaMP-332M A-FP-3000M
59	B07-101	Cu CMP 装置	東京精密	ChaMP-332M A-FP-3000M
60	P07-101	CMP 装置	荏原製作所	F-REX300E
61	B02-101D	Si 深掘りエッチング装置	Applied Materials	Centura Silvia
62	U03-101A	プラズマ CVD 装置	Applied Materials	PRODUCER GT InViaII
63	U06-101	Cu めっき装置	東京エレクトロン	NEXX Cu ECD
64	U07-101	Oxide CMP 装置	Applied Materials	Reflection LK Oxide
65	U12-102	ウェハ接合装置	タツモ	WS3000
66	U07-102	ウェハエッジトリミング装置	ディスコ	DFD6860
67	U07-103	Si 裏面研削研磨装置	ディスコ	DGP8761HC
68	AF03-16	真空蒸着装置	エイコーエンジニアリング	VX-30-S
69	M04-08	評価用小片アニール装置	ULVAC	VHC-P616CP-S
70	M08-55	重ね合わせ精度測定装置	KLA-Tencor	Archer10-AIM
71	P08-116	重ね合わせ精度測定装置	KLA-Tencor	Archer10-AIM
72	M08-07	分光エリプソ膜厚測定装置	KLA-Tencor	ASET-F5
73	M08-101	分光エリプソ膜厚測定装置	KLA-Tencor	ASET-F5X
74	P08-108	分光エリプソ膜厚測定装置	日本セミラボ	μ SE-2500-A
75	I08-101	分光エリプソ膜厚測定装置	J. A. Woollam	M-2000X
76	AF08-12	単色エリプソ膜厚測定装置	ファイブラボ	MARY-102SM
77	P08-104	反射分光膜厚測定装置	Filmetrics	F50-EXR
78	B08-04	蛍光 X 線膜厚測定装置	Philips	PW2820
79	M12-08	蛍光 X 線膜厚測定装置	リガク	System 3272E
80	F08-04	X 線回折装置	リガク	TTR In-plane XRD
81	B12-101	反り/膜応力自動測定装置	FSM	128LC2C
82	M08-12	反り/膜応力測定装置	FSM	128L
83	P08-105	パーティクル検査装置	TOPCON	WM-10
84	P08-106	パーティクル検査装置	TOPCON	WM-10
85	P08-107	全反射蛍光 X 線分析装置	リガク	TXRF 310Fab



No.	装置番号	施設等名称	備考	
			メーカー名	型番
86	AF08-18	全反射蛍光 X 線分析装置	リガク	TXRF 300
87	P08-109	自動濃縮装置	イアス	Expert
	P08-113	ICP-MS 質量分析装置	PerkinElmer	NexION 2000
88	M08-10	シート抵抗測定装置	KLA-Tencor	RS-100
89	M08-25	シート抵抗測定装置	日立国際電気	VR-120/08
90	M08-32	シート抵抗測定装置	日立国際電気	VR-120/08S
91	P08-102	シート抵抗測定装置	日立国際電気	VR300DSE
92	I08-110	測長 SEM 装置	日立ハイテクノロジー	CG5000
93	L08-103	測長 SEM 装置	日立ハイテクノロジー	CG4000
94	P08-101	測長 SEM 装置	日立ハイテクノロジー	S-9380 II
95	P08-103	測長 SEM 装置	日立ハイテクノロジー	S-9380 II
96	P08-115	レビューSEM	Applied Materials	SEMVision G6
97	M08-40	光学顕微鏡	オリンパス	AL3110F
98	M08-50	光学顕微鏡	オリンパス	AL3110 F
99	M12-101	光学顕微鏡	オリンパス	AL110
100	M12-102	光学顕微鏡	オリンパス	AL120
101	J04-106	ヘリウムイオン顕微鏡	Carl Zeiss	ORION Plus
102	B08-02-01	FIB 装置	日立ハイテクノロジー	FB2100
103	AF08-402	走査透過電子顕微鏡	日立ハイテクノロジー	HD-2700
104	B08-02	走査透過電子顕微鏡	日立ハイテクノロジー	HD-2000
105	J03-117	走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジー	S-4700
106	M08-04	走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジー	S-5000
107	B08-12	走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジー	S-5200
108	AF08-14	X 線光電子分光分析装置	アルバック・ファイ	ESCA-1800
109	B10-06	IR-OBIRCH 解析装置	浜松ホトニクス	$\mu$ AMOS
110	J03-116	昇温脱離ガス分析装置	電子科学	WA1000S/W
111	J03-114	赤外分光分析装置	Digilab	Excalibur FTS-3000
112	J03-118	フルオートプローバ テスター	東京エレクトロン Agilent	P-12XL 4073B/N9201A
113	M08-42 M10-01	フルオートプローバ テスター	東京エレクトロン Agilent	P-12XL 4073A
114	M10-05	フルオートプローバ テスター	東京エレクトロン Agilent	P-12XL 4076
115	F10-01	セミオートプローバ テスター	Cascade Agilent	S300-861 4156C/4284A/4294A
116	M10-04 M08-47	セミオートプローバ テスター	Cascade Agilent	S300-561 4156C/4284A/4294A
117	B10-04 B10-05	マニュアルプローバ テスター	Micromanipulator Agilent	Model 9920A 4156B/4284A
118	J03-115	水銀プローバ	Solid State Measurements	SSM 5130
119	SIM-01	露光シミュレータ	KLA-Tencor	PROLITH

## 2. 先端ナノ計測施設（以下「ANCF」という。）

装置番号	施設等名称	備考	
ANCF001	陽電子プローブマイクロアナライザー (PPMA)	2-4C 棟 B023	プローブ分析装置
ANCF002	超伝導蛍光収量 X線吸収微細構造分析装置 (SC-XAFS)	KEK-PF	X線分析装置
ANCF003	ナノ秒可視・近赤外蛍光寿命計測装置 (VITA)	2-10 棟 1112	レーザー分光装置
ANCF004	ナノ秒可視・近赤外過渡吸収分光装置 (VITA)	2-10 棟 033	レーザー分光装置
ANCF005	ピコ秒可視蛍光寿命計測装置 (VITA)	2-10 棟 033	レーザー分光装置
ANCF006	ピコ秒可視・近赤外過渡吸収分光装置 (VITA)	2-10 棟 033	レーザー分光装置
ANCF007	リアル表面プローブ顕微鏡群 1 (RSPM) (JSPM5400 他、改造)	2-1D 棟 125	プローブ顕微鏡
ANCF008	リアル表面プローブ顕微鏡群 2 (RSPM) (SII、RIBM 他、改造、付帯装置)	2-1D 棟 124	プローブ顕微鏡
ANCF009	固体 NMR 装置 (600MHz) (SSNMR)	5-3 棟 1203	NMR 分析装置
ANCF010	固体 NMR 装置 (200MHz) (SSNMR)	5-3 棟 1205	NMR 分析装置
ANCF011	固体 NMR 装置 (20MHz) (SSNMR)	5-3 棟 1205	NMR 分析装置
ANCF014	極端紫外光光電子分光装置 (EUPS)	2-1 棟 A324	光電子分光装置
ANCF015	超伝導蛍光 X線検出器付走査型電子顕微鏡 (SC-SEM)	2-10 棟 B013	分析電子顕微鏡

## 3. 超伝導アナログ・デジタルデバイス開発施設（以下「CRAVITY」という。）

装置番号	施設等名称	備考	
CRAVITY001	i 線ステップ	CR1 イエロールーム	リソグラフィー装置
CRAVITY002	コートデベロッパー (本体)	CR1 イエロールーム	リソグラフィー装置
CRAVITY003	セミオートデベロッパー	CR1 イエロールーム	リソグラフィー装置
CRAVITY004	ウェハー洗浄装置	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置
CRAVITY005	有機洗浄装置 A	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置
CRAVITY006	有機洗浄装置 B	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置
CRAVITY007	Nb-Al ジョセフソン接合作製装置 [In-situ 分析器&オゾン酸化器付]	CR1 クリーンルーム	成膜装置
CRAVITY008	Nb-Al ジョセフソン接合作製装置 [標準型]	CR1 クリーンルーム	成膜装置
CRAVITY009	NbN ジョセフソン素子作製装置	CR1 クリーンルーム	成膜装置
CRAVITY010	マルチターゲット (六源) スパッタ装置	CR1 クリーンルーム	成膜装置
CRAVITY011	絶縁膜作製装置	CR1 クリーンルーム	成膜装置
CRAVITY012	TEOS-CVD	CR1 クリーンルーム	成膜装置
CRAVITY013	反応性イオンエッチング装置 Samco-I	CR1 クリーンルーム	エッチング装置
CRAVITY014	反応性イオンエッチング装置 Samco-II	CR1 クリーンルーム	エッチング装置
CRAVITY015	反応性イオンエッチング装置 Samco-III	CR1 クリーンルーム	エッチング装置
CRAVITY016	反応性イオンエッチング装置 (Ulvac)	CR1 クリーンルーム	エッチング装置
CRAVITY017	ICP 型反応性イオンエッチング装置	CR1 クリーンルーム	エッチング装置
CRAVITY019	イオンミリング装置	CR1 クリーンルーム	ミリング装置
CRAVITY020	酸系ウェットエッチング装置	CR1 イエロールーム	エッチング装置
CRAVITY021	高温熱処理装置 (RTA)	CR1 クリーンルーム	測定装置
CRAVITY022	オートプローバ	CR1 クリーンルーム	測定装置
CRAVITY023	マニュアルプローバ	CR1 クリーンルーム	測定装置
CRAVITY024	シート抵抗測定装置	CR1 クリーンルーム	測定装置

装置番号	施設等名称	備考	
CRAVITY025	ナノサーチ顕微鏡	CR1 クリーンルーム	測定装置
CRAVITY026	レーザー顕微鏡	CR1 クリーンルーム	測定装置
CRAVITY027	触針式段差計( $\alpha$ ステップ)	CR1 クリーンルーム	測定装置
CRAVITY028	CMP 装置 1	CR1 一般実験室	表面処理装置
CRAVITY029	CMP 装置 2	CR1 一般実験室	表面処理装置
CRAVITY030	ダイシングソー1	CR1 一般実験室	加工装置

#### 4. ナノプロセッシング施設 (以下「NPF」という。)

装置番号	施設等名称	備考	
NPF001	電子ビーム描画装置(CRESTEC)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー装置
NPF003	イオンコーター	CR1 クリーンルーム	表面処理装置
NPF004	電界放出形走査電子顕微鏡[S4800_FE-SEM]	CR1 クリーンルーム	観察装置
NPF005	低真空走査電子顕微鏡	CR1 クリーンルーム	観察装置
NPF006	マスクレス露光装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー装置
NPF008	スピニングコーター	CR2 イエロールーム	リソグラフィー装置
NPF009	コンタクトマスクアライナー[MJB4]	CR1 イエロールーム	リソグラフィー装置
NPF010	反転露光用全面 UV 照射装置	CR2 クリーンルーム	リソグラフィー装置
NPF011	i 線露光装置	CR3 イエロールーム	リソグラフィー装置
NPF012	ドラフトチャンバー(右)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー装置
NPF013	ドラフトチャンバー(左)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー装置
NPF014	有機ドラフトチャンバー	CR1 クリーンルーム	ウェット処理装置
NPF015	酸アルカリドラフトチャンバー	CR1 クリーンルーム	ウェット処理装置
NPF016	スターラーウォーターバス[SWB-10L-1]	CR1 クリーンルーム	ウェット処理装置
NPF017	スマートウォーターバス[TB-1N]	CR2 イエロールーム	リソグラフィー装置
NPF018	反応性イオンエッチング装置 (RIE)	CR1 クリーンルーム	エッチング装置
NPF019	多目的エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング装置
NPF021	プラズマアッシャー	CR1 クリーンルーム	表面処理装置
NPF022	UV オゾンクリーナー	CR1 クリーンルーム	表面処理装置
NPF023	電子ビーム真空蒸着装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置
NPF024	抵抗加熱型真空蒸着装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置
NPF025	スパッタ成膜装置(芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜装置
NPF026	RF・DC スパッタ成膜装置(ULVAC)	CR1 クリーンルーム	成膜装置
NPF029	メッキ装置	CR1 クリーンルーム	成膜装置
NPF030	プラズマ CVD 薄膜堆積装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置
NPF031	原子層堆積装置[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜装置
NPF032	クロスセクションポリッシャー(ALD 付帯)	CR5 クリーンルーム	ミリング装置
NPF033	アルゴンミリング装置	CR5 クリーンルーム	ミリング装置
NPF034	集束イオンビーム加工観察装置(FIB)	2F 一般実験室	イオンビーム装置
NPF035	イオンコーター(FIB 付帯)	2F 一般実験室	表面処理装置
NPF038	二次イオン質量分析装置(D-SIMS)	2F 一般実験室	イオンビーム装置
NPF039	オゾンクリーナー(SIMS 付属)	2F 一般実験室	表面処理装置

装置番号	施設等名称	備考	
NPF040	多目的高速加熱ランプ炉(RTA)	CR1 クリーンルーム	熱処理装置
NPF041	ウェハー酸化炉	CR1 クリーンルーム	熱処理装置
NPF042	クリーンオープン(右)	CR2 イエロールーム	熱処理装置
NPF043	クリーンオープン(左)	CR2 イエロールーム	熱処理装置
NPF044	マッフル炉	CR1 クリーンルーム	熱処理装置
NPF045	触針式段差計	CR1 クリーンルーム	測定装置
NPF046	走査プローブ顕微鏡 SPM1 [NanoscopeIV/Dimension3100]	CR1 クリーンルーム	プローブ装置
NPF047	走査プローブ顕微鏡 SPM2[SPM-9600/9700]	2F 一般実験室	プローブ装置
NPF048	ナノサーチ顕微鏡 SPM3[SFT-3500]	CR1 クリーンルーム	プローブ装置
NPF049	ナノプローバ[N-6000SS]	2F 一般実験室	プローブ装置
NPF050	四探針プローブ抵抗測定装置	CR5 クリーンルーム	測定装置
NPF051	デバイスパラメータ評価装置	CR1 クリーンルーム	測定装置
NPF052	デバイス容量評価装置	CR1 クリーンルーム	測定装置
NPF053	ワイヤーボンダー	CR1 クリーンルーム	加工装置
NPF054	ダイシングソー	CR4 クリーンルーム	加工装置
NPF055	スクライバー	CR4 クリーンルーム	加工装置
NPF056	研磨機	CR4 クリーンルーム	加工装置
NPF057	ラッピングマシン(CMP)	CR4 クリーンルーム	加工装置
NPF058	ウェハー圧着機	CR1 クリーンルーム	加工装置
NPF059	レーザー顕微鏡[VK-8510] (2F)	2F 一般実験室	観察装置
NPF060	短波長レーザー顕微鏡[VK-9700]	CR1 クリーンルーム	観察装置
NPF061	短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100]	CR1 クリーンルーム	観察装置
NPF062	全焦点顕微鏡	2F 一般実験室	観察装置
NPF063	分光エリプソメータ	CR1 クリーンルーム	分光装置
NPF064	解析用 PC(分光エリプソメータ用)	2F データ解析室	その他
NPF065	顕微レーザーラマン分光装置(RAMAN)	CR1 クリーンルーム	分光装置
NPF066	顕微フーリエ変換赤外分光装置(FT-IR)	CR1 クリーンルーム	分光装置
NPF067	解析用 PC(CAD 及び SPM, FT-IR, RAMAN 用)	2F データ解析室	その他
NPF068	磁気特性測定システム(MPMS)	2F 一般実験室	測定装置
NPF070	エックス線回折装置(XRD)	2F 一般実験室	エックス線装置
NPF071	薄膜エックス線回折装置	2F 一般実験室	エックス線装置
NPF072	微小部蛍光エックス線分析装置	CR1 クリーンルーム	エックス線装置
NPF073	解析用 PC(CAD 及び X 線解析用)	2F データ解析室	その他
NPF074	エックス線光電子分光分析装置(XPS)	2F 一般実験室	エックス線装置
NPF075	解析用 PC(XPS 用)	2F データ解析室	その他
NPF076	解析用 PC1(一般解析用)	2F データ解析室	その他
NPF077	解析用 PC2(一般解析用)	2F データ解析室	その他
NPF078	解析用 PC3(一般解析用)	2F データ解析室	その他
NPF079	解析用 PC4(一般解析用)	2F データ解析室	その他
NPF080	ヘリウムイオン顕微鏡	SCR 産学官連携研究棟	観察装置
NPF081	プラズマ CVD 薄膜堆積装置(SiN)	CR5 クリーンルーム	成膜装置

装置番号	施設等名称	備考	
NPF082	化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング装置
NPF084	デジタルマイクロスコープ	CR1 クリーンルーム	観察装置
NPF085	物理特性測定装置(PPMS)	2F 一般実験室	測定装置
NPF086	マニュアルウェハブローバー(2F)	2F 一般実験室	観察装置
NPF087	ワイヤーボンダー(2F)	2F 一般実験室	加工装置
NPF088	電界放出型走査電子顕微鏡[S4500/FE-SEM](2F)	2F 一般実験室	観察装置
NPF089	赤外線ランプ拡散炉(RTA)	CR5 クリーンルーム	熱処理装置
NPF090	レーザー加工装置	CR4 クリーンルーム	加工装置
NPF091	自動塗布現像装置	CR2 クリーンルーム	リソグラフィ装置
NPF092	高圧ジェットリフトオフ装置	CR2 クリーンルーム	リソグラフィ装置
NPF093	高速電子ビーム描画装置(エリオニクス)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ装置
NPF094	解析用PC(CAD及び近接効果補正用)	2F データ解析室	その他
NPF095	RFDCスパッタ堆積装置(芝浦)	CR5 クリーンルーム	成膜装置
NPF096	単波長エリブソメータ	CR1 クリーンルーム	測定装置
NPF097	両面アライナー	CR2 クリーンルーム	リソグラフィ装置
NPF098	ECRスパッタ成膜・ミリング装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置
NPF099	原子層堆積装置[AD-100LP]	CR5 クリーンルーム	成膜装置

#### 5. 蓄電池基盤プラットフォーム(以下「BRP」という。)

装置番号	施設等名称	備考	
BRP-01	中型電池非破壊観察装置 X線CTスキャナー(東芝TOSCANER-34500FD)	関西センターC-2棟 1002室	エックス線装置
BRP-02	中型電池物性解析装置 レーザーラマン顕微鏡(NanoPhoton RAMANtouch VIS-NIR-LT)	関西センターC-1棟 1103-1室	分光装置
BRP-03	中型電池物性解析装置 カルベ式熱量計(Setaram C-600)	関西センターC-1棟 1103-1室	分析装置
BRP-04	中型電池物性解析装置 熱分析装置(島津DTG-60、TMA-60、DSC-60plus)	関西センターC-1棟 1103-1室	分析装置

#### 6. MEMS研究開発拠点(以下「MEMS」という。)

装置番号	施設等名称	備考		
		試料寸法	設置場所	用途
MEMS001	ウェハディップ洗浄装置	200mm/300mm	TKB812-F	処理
MEMS002	ウェハスピンド洗浄装置	200mm/300mm	TKB812-F	処理
MEMS003	有機ドラフト	300mm以下	TKB812-F	処理
MEMS004	異方性ウェットエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
MEMS005	IPAベーパー乾燥機	200mm	TKB812-F	処理
MEMS006	i-線ステッパ	200mm	TKB812-F	加工
MEMS007	マスク露光装置	150mm/200mm	TKB812-F	加工
MEMS008	マスクレス露光装置	500mm角以下	TKB812-F	加工
MEMS010	光学顕微鏡	300mm以下	TKB812-F	分析・評価
MEMS011	Si酸化膜プラズマCVD装置	200mm/300mm	TKB812-F	加工
MEMS012	スパッタ	200mm	TKB812-B	加工

装置番号	施設等名称	備考		
		試料寸法	設置場所	用途
MEMS013	酸化炉	200mm	TKB812-F	加工
MEMS014	アニール炉	200mm	TKB812-F	加工
MEMS015	Si 窒化膜減圧 CVD 装置	200mm	TKB812-F	加工
MEMS016	ポリ Si 減圧 CVD 装置	200mm	TKB812-F	加工
MEMS017	金属膜ドライエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
MEMS018	Si 酸化膜ドライエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
MEMS019	8"Si 深掘ドライエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
MEMS020	12"Si 深掘ドライエッチング装置	300mm	TKB812-F	加工
MEMS021	犠牲層ドライエッチング装置	100/150/200mm	TKB812-F	加工
MEMS022	アッシャー	200mm/300mm	TKB812-F	加工
MEMS023	光学検査顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
MEMS024	段差測定器	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
MEMS025	エリプソメーター	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
MEMS026	膜厚測定器	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
MEMS027	ウェハ塵埃検査装置	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
MEMS028	干渉型表面形状評価装置	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
MEMS029	シート抵抗プローバー	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
MEMS030	赤外線レーザ顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
MEMS031	レーザ顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
MEMS032	ブレードダイサー	300mm 以下	2A-CR	加工
MEMS033	レーザステルスダイサー	200mm 以下	2A-CR	加工
MEMS034	光学顕微鏡	300mm 以下	2A-CR	分析・評価
MEMS035	大面積ナノインプリント装置	200mm 角以下	2A-CR	加工
MEMS036	電子ビーム/抵抗蒸着装置	200mm/300mm	TKB812-B	加工
MEMS037	熱処理装置	200mm	TKB812-B	加工
MEMS038	チップ to ウェハ接合装置	100/150/200/300mm	TKB812-B	加工
MEMS039	ウェハ to ウェハ接合装置	100/150/200mm	TKB812-B	加工
MEMS040	パリレンコータ	100mm	2G-CR	加工
MEMS041	光表面処理装置	200mm	TKB812-B	処理
MEMS042	12"ウェハ常温接合装置	100/150/200/300mm	3F-CR	加工
MEMS043	測長 SEM	200mm	TKB812-B	分析・評価
MEMS044	分析 SEM	100/150/200/300mm	TKB812-B	分析・評価
MEMS045	超音波顕微鏡	300mm 以下	TKB812-B	分析・評価
MEMS046	赤外線顕微鏡	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
MEMS047	薄膜応力評価装置	200mm	TKB812-B	分析・評価
MEMS048	X 線 CT 評価装置	200mm/300mm	TKB812-B	分析・評価
MEMS049	テスタープローバー	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
MEMS050	光学顕微鏡	300mm 以下	TKB812-B	分析・評価
MEMS052	高温熱ナノインプリント装置	70mm 以下	2A 実験室	加工
MEMS053	ダイシエアテスタ	100mm 以下	TKB812-B	分析・評価

装置番号	施設等名称	備考		
		試料寸法	設置場所	用途
MEMS054	大面積コーターディベロッパ	500mm 角以下	TKB812-F	加工
MEMS055	レジストスプレーコータ	200mm 角以下	2G-CR	加工
MEMS056	反応性イオンエッチング装置	200mm	2G-CR	加工
MEMS057	全反射蛍光 X 線分析装置	200mm/300mm	TKB812-B	分析・評価
MEMS058	無機ドラフト	300mm 以下	TKB812-F	処理
MEMS059	レジスト塗布現像装置	200mm 以下	TKB812-F	加工
MEMS060	イオンミリング装置	200mm 以下	TKB812-B	加工
MEMS061	電界放射型 SEM	100mm 以下	2A 実験室	分析・評価
MEMS062	4"Si 深掘ドライエッチング装置	100mm 以下	2G-CR	加工
MEMS063	4"スパッタ装置	100mm 以下	2G-CR	加工
MEMS064	化学ドラフト	100mm 以下	2G-CR	加工
MEMS065	4"酸化炉	100mm 以下	2G-CR	加工
MEMS066	4"フォトリソグラフィ設備	100mm 以下	2G-CR	加工・処理
MEMS067	レーザ描画装置	100mm 以下	2G-CR	加工
MEMS068	小型ナノインプリント装置	20mm 角以下	2G-CR	加工
MEMS069	自動光学顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
MEMS070	レーザードップラー測定器	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
MEMS071	フーリエ変換赤外分光装置	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価

## 7. 先端バイオ計測施設（以下「BIO」という。）

装置番号	施設等名称	備考	
BIO-001	糖鎖プロファイル解析システム	2-12 棟 224	測定装置
BIO-002	植物転写因子相互作用解析システム	6-8 棟 2205	測定装置

(別紙第1)

## 利用料等の算定方式について

第6条第4項の算定方式は、以下のとおり。

### 1. SCR 及び CRAVITY の標準レシピを使用する工程を利用した場合

#### ① 共用施設等使用料 (第6条第1項第1号) :

下表の(1)に定める共用施設等使用料単価に使用したウェハ数及び工程数の積を乗じた額。

#### ② 運転費 (第6条第1項第2号) :

研究所の役職員等から同装置の操作、運転等の役務提供を受けた場合には、下表の(2)に定める運転費単価に使用したウェハ数及び工程数の積を乗じた額

#### ③ 技術指導費等 (第6条第1項第3号及び第4号) :

研究所の役職員等から同装置の操作及び運転方法、試料等の作製方法、データ等の解析方法等についての技術指導を受けた場合又は研究所の役職員等から同装置を用いた観察、分析、解析、加工、試料作製等に関する技術代行を受けた場合には、下表の(3)に定める技術指導費等単価に従事時間を乗じた額

#### ④ 追加料金 (第6条第1項第5号) :

追加的に必要な作業等が発生する場合には、以下に定める額。なお、以下の追加的に必要な作業等は、いずれも第2条第1項の「利用」に含まれるものとする。

ア 改造費：共用施設等を改造するために必要な費用で、具体的な改造工事の内容により実費相当額を算定して積算した額

イ 復元費：改造又は変造した共用施設等を原状復帰させるために必要な費用で、具体的な復元工事の内容により実費相当額を算定して積算した額

ウ 他の共用施設等の利用に係る経費：第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、当該共用施設等以外の共用施設等を用いる場合の共用施設等使用料並びに研究所の役職員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額

エ 研究所以外の機関の施設等の利用に関する経費：第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、研究所以外の第三者機関（民間企業を含む。以下同じ。）の施設等を用いる場合の施設利用料並びに当該第三者機関の役職員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額

オ 上記エの場合における研究所の役職員等の従事に要する経費：上記エの場合における研究所の役職員等による操作、運転、観察、分析、解析、加工、試料作製等が追加的に必要な場合の費用の額

カ その他実費：共用施設等の利用に際し、研究所において追加的な購入が必要となる器具、材料、薬品その他の消耗品及び第三者機関へ外注する評価、分析、技術代行その他の役務であって、あらかじめ研究所と利用者が費用負担について合意した費用の額

#### ⑤ 運営管理費 (第6条第1項第6号) :

上述①～④の額に15パーセントを乗じた額

#### (1) 共用施設等使用料

(a) 共用施設等使用料単価	(b) 使用ウェハ数×工程数	(a) × (b) 共用施設等使用料
円	枚・回	円

#### (2) 運転費

(c) 運転費単価	(d) 使用ウェハ数×工程数	(c) × (d) 運転費
円	枚・回	円

#### (3) 技術指導費等

(e) 技術指導費等単価	(f) 従事時間	(e) × (f) 技術指導費等
-----------------	-------------	---------------------



円	時間	円
---	----	---

(3) の金額は消費税等抜きである。

(a) (c) (e) の単価は共用施設等ごとに設定し、毎年度改定する。

利用が不可能になり、又は利用を中止した場合における仕掛品のウエハに係る共用施設等使用料及び  
運転費については、仕掛中の工程までの利用時間に相当する額とする。

なお、利用者の規模等を考慮し、利用料等を調整する場合もある。

2. SCR、ANCF 及びCRAVITY のチューニングが必要な工程を利用した場合、並びに NPF、BRP 及びMEMS を利用した場合

① 共用施設等使用料（第6条第1項第1号）：

下表の（1）に定める時間あたりの共用施設等使用料単価に使用時間に乗じた額。

② 運転費（第6条第1項第2号）：

研究所の役職員等から同装置の操作、運転等の役務提供を受けた場合には、下表の（2）に定める運転費単価に従事時間に乗じた額

③ 技術指導費等（第6条第1項第3号及び第4号）：

研究所の役職員等から同装置の操作及び運転方法、試料等の作製方法、データ等の解析方法等についての技術指導を受けた場合又は研究所の役職員等から同装置を用いた観察、分析、解析、加工、試料作製等に関する技術代行を受けた場合には、下表の（3）に定める技術指導費等単価に従事時間に乗じた額

④ 追加料金（第6条第1項第5号）：

追加的に必要な作業等が発生する場合には、以下に定める額。なお、以下の追加的に必要な作業等は、いずれも第2条第1項の「利用」に含まれるものとする。

ア 改造費：共用施設等を改造するために必要な費用で、具体的な改造工事の内容により実費相当額を算定して積算した額

イ 復元費：改造又は変造した共用施設等を原状復帰させるために必要な費用で、具体的な復元工事の内容により実費相当額を算定して積算した額

ウ 他の共用施設等の利用に係る経費：第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、当該共用施設等以外の共用施設等を用いる場合の共用施設等使用料並びに研究所の役職員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額

エ 研究所以外の機関の施設等の利用に関する経費：第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、研究所以外の第三者機関（民間企業を含む。以下同じ。）の施設等を用いる場合の施設利用料並びに当該第三者機関の役職員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額

オ 上記エの場合における研究所の役職員等の従事に要する経費：上記エの場合における研究所の役職員等による操作、運転、観察、分析、解析、加工、試料作製等が追加的に必要な場合の費用の額

カ その他実費：共用施設等の利用に際し、研究所において追加的な購入が必要となる器具、材料、薬品その他の消耗品及び第三者機関へ外注する評価、分析、技術代行その他の役務であって、あらかじめ研究所と利用者が費用負担について合意した費用の額

⑤ 運営管理費（第6条第1項第6号）：

上述①～④の額に15パーセントに乗じた額

(1) 共用施設等使用料

(a) 共用施設等使用料単価	(b) 使用時間	(a) × (b) 共用施設等使用料
円	時間	円

(2) 運転費

(c) 運転費単価	(d) 従事時間	(c) × (d) 運転費
円	時間	円

(3) 技術指導費等

(e) 技術指導費等単価	(f) 従事時間	(e) × (f) 技術指導費等
円	時間	円

(3) の金額は、消費税等抜きである。

(a) (c) (e) の単価は共用施設等ごとに設定し、毎年度改定する。

文部科学省委託事業のために利用する場合には、第6条第1項ただし書きにより運営管理費は含まないものと

し、及び同条第2項により通常の単価より低い単価を設定する。  
なお、利用者の規模等を考慮し、利用料等を調整する場合もある。

3. ANCF の標準レシピを使用する工程を利用した場合、及び BIO を利用した場合

① 共用施設等使用料（第6条第1項第1号）：

下表の（1）に定める共用施設等使用料単価に使用した試料数及び工程数の積を乗じた額。

② 運転費（第6条第1項第2号）：

研究所の役職員等から同装置の操作、運転等の役務提供を受けた場合には、下表の（2）に定める運転費単価に使用した試料数及び工程数の積を乗じた額

③ 技術指導費等（第6条第1項第3号及び第4号）：

研究所の役職員等から同装置の操作及び運転方法、試料等の作製方法、データ等の解析方法等についての技術指導を受けた場合又は研究所の役職員等から同装置を用いた観察、分析、解析、加工、試料作製等に関する技術代行を受けた場合には、下表の（3）に定める技術指導費等単価に従事時間を乗じた額

④ 追加料金（第6条第1項第5号）：

追加的に必要な作業等が発生する場合には、以下に定める額。なお、以下の追加的に必要な作業等は、いずれも第2条第1項の「利用」に含まれるものとする。

- ア 改造費：共用施設等を改造するために必要な費用で、具体的な改造工事の内容により実費相当額を算定して積算した額
- イ 復元費：改造又は変造した共用施設等を原状復帰させるために必要な費用で、具体的な復元工事の内容により実費相当額を算定して積算した額
- ウ 他の共用施設等の利用に係る経費：第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、当該共用施設等以外の共用施設等を用いる場合の共用施設等使用料並びに研究所の役職員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額
- エ 研究所以外の機関の施設等の利用に関する経費：第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、研究所以外の第三者機関（民間企業を含む。以下同じ。）の施設等を用いる場合の施設利用料並びに当該第三者機関の役職員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額
- オ 上記エの場合における研究所の役職員等の従事に要する経費：上記エの場合における研究所の役職員等による操作、運転、観察、分析、解析、加工、試料作製等が追加的に必要な場合の費用の額
- カ その他実費：共用施設等の利用に際し、研究所において追加的な購入が必要となる器具、材料、薬品その他の消耗品及び第三者機関へ外注する評価、分析、技術代行その他の役務であって、あらかじめ研究所と利用者が費用負担について合意した費用の額

⑤ 運営管理費（第6条第1項第6号）：

上述①～④の額に15パーセントを乗じた額

(1) 共用施設等使用料

(a) 共用施設等使用料単価	(b) 使用試料数×工程数	(a) × (b) 共用施設等使用料
円	個・回	円

(2) 運転費

(c) 運転費単価	(d) 使用試料数×工程数	(c) × (d) 運転費
円	個・回	円

(3) 技術指導費等

(e) 技術指導費等単価	(f) 従事時間	(e) × (f) 技術指導費等
円	時間	円

(3) の金額は、消費税等抜きである。

(a) (c) (e)の単価は共用施設等ごとに設定し、毎年度改定する。

利用が不可能になり、又は利用を中止した場合における仕掛品の試料に係る共用施設等使用料及び運転費については、仕掛中の工程までの利用時間に相当する額とする。

文部科学省委託事業のために利用する場合には、第6条第1項ただし書きにより運営管理費は含まないものとし、及び同条第2項により通常の単価より低い単価を設定する。

なお、利用者の規模等を考慮し、利用料等を調整する場合もある。

(別紙様式1)

## 共用施設等利用申込書

年 月 日

国立研究開発法人産業技術総合研究所  
理事長名

(利用希望者)  
〇〇株式会社  
(〇〇県〇〇市〇〇町 1-1)  
代表者名 (印)

国立研究開発法人産業技術総合研究所共用施設等利用約款に基づき、下記のとおり、利用を申込みます。また、利用にあたって次の各項に同意します。

- ① 国立研究開発法人産業技術総合研究所共用施設等利用約款において定められた全ての事項を遵守します。
- ② 回答書に利用条件が付された場合には、その条件に従います。
- ③ その他、利用にあたり、研究所並びに研究所の施設管理者及び役職員等の指示に従います。

### 記

- (1) 利用を希望する共用施設等の名称
- (2) 利用目的及び概要  
(利用の実態が分かるように記載してください。ただし、共用施設等の管理運営上特に必要と認められる場合を除き、知的財産権に係る秘密を開示する必要はありません。)
- (3) 利用の希望期間
- (4) 利用する従業員の氏名、所属及び連絡先  
(全員の氏名、所属及び連絡先を記載してください。)
- (5) 役務提供、技術指導及び技術代行の希望の有無
- (6) 施設管理者の内諾
  - ① 該当する施設管理者の氏名：
  - ② 内諾を得た年月日：
  - ③ 内諾を得た者の所属及び氏名：
- (7) 成果の公開を前提にしているか否か及び成果の非公開の申入れをするか (第16条第1項)  
(成果の公開を前提にしつつも公開できないことがあれば、理由とともに記載してください。)
- (8) 利用料等の納付方法における要望  
(利用料等の納付方法における要望について、利用前払い及び精算方式又は利用後精算方式を選択して記載してください。精算処理の受付期限がある場合は期限となる日付を明記してください。また、貴組織の支払いスケジュール「例 (25日締め、翌月末払い) 等」が決まっておりますらご記載ください。)
- (9) 回答書の原本郵送希望の有無  
(回答書は、メール添付にてお送り致しますが、原本の郵送をご希望の方は、ご連絡下さい。)
- (10) 請求書に関する連絡先 (送付先)  
(郵便番号、住所、部署名・氏名等、メールアドレス、電話番号など、請求書等に関する連絡時の送付先に関して記載してください)

(注意事項)

## 利用申込みの方法

利用の希望者は、あらかじめ下記申込書の提出先のURLに示す施設管理者と共用施設等の空き状況、操作運転に関する役務提供の可否、技術指導及び技術代行実施の可否等について相談し、利用の内諾を得て、申込書に必要事項を記入・押印のうえ、申込書をスキャン、PDFファイルにして、ご利用になる施設の受付窓口まで電子メールにて提出してください。

### 1. 申込書の提出先

スーパークリーンルームステーション (SCR) E-mail: scr_contact-ml@aist.go.jp	先端ナノ計測施設 (ANCF) E-mail: ancf-contact-ml@aist.go.jp
超伝導アナログ・デジタルデバイス開発施設 (CRAVITY) E-mail: cravity-contact-ml@aist.go.jp	ナノプロセッシング施設 (NPF) E-mail: tia-npf-ml@aist.go.jp
蓄電池基盤プラットフォーム (BRP) E-mail: brp-contact-ml@aist.go.jp	MEMS研究開発拠点 (MEMS) E-mail: tia_mems_contact-ml@aist.go.jp
先端バイオ計測施設 (BIO) E-mail: bio-tia-ml@aist.go.jp	

### 2. 利用の受入可否の回答

利用を希望する共用施設等を管理している研究ユニット等と調整を行い、利用の受入れの可否、利用条件等を原則 10 営業日以内にご返事します。

3. 利用にあたり、利用者が研究所内で自ら作業を行う場合には、「履歴書 (下記履歴書の記載事項を参照)」を別途申込書の提出先へ提出してください。

### 履歴書の記載事項

1 形式	原則として本人が作成したものであれば形式は問わない。		
2 言語	日本国籍の者については日本語 外国籍の者については英語又は日本語 なお、英語以外の外国語で記載された履歴書は、必ず日本語の翻訳を添付すること。		
3 記載事項	(1)	必須	名前
	(2)	必須	名前のふりがな
	(3)	必須	性別
	(4)	必須	生年月日
	(5)	必須	国籍
	(6)	必須	卒業学校名・学部学科 大学 (学士) 若しくは高校から記載する 外国の学校の場合には英語による標記を含む
	(7)	必須	職歴 外国の組織等の場合には英語による標記を含む。
	(8)	必須	現在の所属組織等名 外国の組織等の場合には英語による標記を含む。
	(9)	必須	現在の所属組織等の役職名等 (役職・学位・称号等)
	(10)	必須	現在行っている研究の内容
	(11)	—	簡単な業績紹介

- ・大学入学・卒業年月日、職歴・所属機関の配属年月は必須です。
- ・学歴・職歴に 1 年以上の空白期間がないように記載をお願いいたします。  
空白期間がある場合は、どちらで何をされていたかを記載してください。

(別紙様式2)

番号  
年月日

利用者  
代表者名

国立研究開発法人産業技術総合研究所  
理事長名

## 共用施設等利用回答書

○年○月○日付けで申込みのあった標記の件については、下記のとおり申込みをお受けいたします。

### 記

- (1) 共用施設等の名称
- (2) 利用目的及び概要
- (3) 利用の期間 年 月 日～ 年 月 日
- (4) 利用する従業員の氏名、所属及び連絡先
- (5) 役務提供、技術指導及び技術代行の有無
- (6) 施設管理者氏名、所属及び連絡先
- (7) 成果公開又は非公開
- (8) 利用にあたっての条件等

※なお、国立研究開発法人産業技術総合研究所共用施設等利用約款に規定されている事項を遵守してください。

- (9) 利用料等の額 円
- (10) 利用料等の納付方法、期日  
(利用料等の納付を利用前払い及び精算方式とする場合)  
本状に同封された研究所が発行する請求書に従い、共用施設等の利用料等の全額を所定の期日までに納付してください。  
なお、利用終了後、精算が必要な場合には、後日利用料等の追加徴取又は返還を行います。

若しくは、

(利用料等の納付を利用後精算方式とする場合)  
利用後、研究所が発行する請求書に従い、共用施設等の利用料等の全額を所定の期日までに納付してください。精算処理の受付期限がある場合は期限となる日付を明記してください。

又は、

○年○月○日付けで申込みのあった標記の件については、・・・・(理由)・・・・のため、申込みをお受けできません。

### 記

- (1) 共用施設等の名称
- (2) 利用目的及び概要
- (3) 利用希望期間
- (4) 利用する従業員の氏名及び所属